
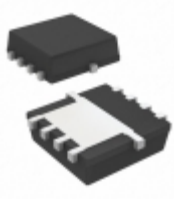



	<h2>SI7686DP-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7686DP-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7686DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 223585 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI7686DP-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	223585 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 35A (Tc) 5W (Ta), 37.9W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 37.9W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 13.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1220pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7686DP-T1-GE3DKR

SI7686DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7686DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7686DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7686DP-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI7703EDN-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.3A 1212-8</p>	 <p><b>SI7686DP-T1</b> VISHAY SI7686DP-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI7686DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7703EDN-T1</b> VISHAY SI7703EDN-T1 VISHAY</p>
 <p><b>SI7686DP</b> VISHAY SI7686DP VISHAY</p>	 <p><b>SI7686DP-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7686DP-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7686DP P/b</b> VISHAY VISHAY QFN</p>

### heiße Teile

Mehr

SI7660CJ	SI7660DY	SI7660DY-T1	SI7660DY-T1-E3	SI7661CJ
SI7661CSA	SI7661CSA+	SI7668ADP-T1-E3	SI7668ADP-T1-E3	SI7668ADP-T1-GE3
SI7668ADP-T1-GE3	SI7674DP	SI7674DP-T1-GE3	SI7674DP-T1-GE3	SI7682DP
SI7682DP-T1-E3	SI7682DP-T1-E3	SI7682DP-T1-GE3	SI7682DP-T1-GE3	SI7682DY-T1-GE3
SI7684DP-T1-GE3	SI7686DP	SI7686DP-T1	SI7686DP-T1-E3	SI7686DP-T1-E3
SI7686DP-T1-GE3	SI7703DN	SI7703EDN	SI7703EDN-T1	SI7703EDN-T1-E3
SI7703EDN-T1-E3	SI7703EDN-T1-GE3	SI7703EDN-T1-GE3	SI7703EDN-TI-E3	SI7705DN
SI7705DN-T1	SI7705DN-T1-E3	SI7716ADN	SI7716ADN-T1-E3	SI7716ADN-T1-GE3
SI7716ADN-T1-GE3	SI7716ADN-TI-GE3	SI7716DN-T1-GE3	SI7720DN-T1-E3	SI7720DN-T1-GE3
SI7720DN-T1-GE3	SI7726DN	SI7726DN-T1-E3	SI7726DN-T1-GE3	SI7726DN-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited